

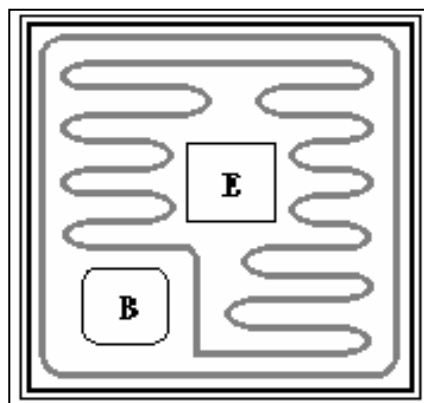


128M 晶体管芯片说明书

芯片简介

- 芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
- 芯片代码：C060AJ-02
- 芯片厚度：240 ± 20μm
- 管芯尺寸：600 × 600μm²
- 焊位尺寸：B 极 130×150μm² ; E 极 140×130μm²
- 电极金属：铝
- 背面金属：金
- 典型封装：STC128M , H128M

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92S)

- T_{stg}——贮存温度..... -55~150
- T_j——结温..... 150
- P_C——集电极耗散功率..... 400mW
- V_{CB0}——集电极—基极电压..... 20V
- V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 15V
- V_{EBO}——发射极—基极电压..... 6.5V
- I_C——集电极电流..... 1.5A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92S)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	20			V	I _C =50μA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	15			V	I _C =1mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6.5			V	I _E =50μA , I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =20V , I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V _{EB} =6V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	150				V _{CE} =1V , I _C =100mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.3	V	I _C =500mA , I _B =50mA
f _T	特征频率		260		MHz	V _{CE} =5V , I _C =50mA
C _{ob}	共基极输出电容		5		Pf	V _{CB} =10V , I _E =0 , f=1MHz
R _{ON}	通态电阻		0.6		Ω	V _{IN} =0.3V , I _B =1mA , f=1KHz